



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

К. Маркса пр., 20, г. Новосибирск, 630073
Телетайп: 133432KADR RU
Телефон: (383) 346-50-01, факс: (383) 346-02-09,
E-mail: rector@nstu.ru,
http://www.nstu.ru

ОКПО 02068953, ОГРН 1025401485010

ИНН/КПП 5404105174/540401001

29 СЕН 2023

от _____

№ 3491 / ППимэ

Председателю диссертационного
совета 24.2.415.03 на базе
Томского государственного
университета систем управления
и радиоэлектроники (ТУСУР),
д.ф.-м.н., профессору
Шандарову С.М.

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,
ТУСУР

Уважаемый Станислав Михайлович!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» подтверждает согласие выступить ведущей организацией по диссертационной работе **Задорожного Олега Федоровича «Повышение эффективности светодиодных источников излучения на основе InGaN/GaN»** по специальности **1.3.5 – «Физическая электроника»** на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Необходимые сведения прилагаются.

Приложение: сведения о ведущей организации на 3 стр. в 1 экз.

Проректор по научной работе

Отто А.И.



Исп. Остертак Д.И.,
Тел. 8 (383) 346-08-77

Сведения о ведущей организации
по диссертационной работе Задорожного Олега Федоровича
на тему «Повышение эффективности светодиодных источников
излучения на основе InGaN/GaN» на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности
1.3.5 – «Физическая электроника»

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», Новосибирский государственный технический университет, НГТУ
Почтовый индекс, адрес организации	Россия, 630073, г. Новосибирск, проспект, К. Маркса, 20.
Веб-сайт	www.nstu.ru
Телефон	8 (383) 346-50-01
Адрес электронной почты	rector@nstu.ru
Список основных публикаций работников структурного подразделения, в котором будет готовиться отзыв, по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<p>1) Electrophysical parameter comparison of 2DEG in AlGaIn/GaN heterostructures grown by the NH₃-MBE technique on sapphire and silicon substrates / T. Malin, D. Milakhin, D. Prorasov, K. Zhuravlev [et. al.]. - DOI 10.1016/j.jcrysgr.2022.126669. - Text : direct // Journal of Crystal Growth. - 2022. - Vol. 588. - Art. 126669 (7 p.).</p> <p>2) Effect of Titanium and Molybdenum Cover on the Surface Restructuration of Diamond Single Crystal during Annealing / A. V. Okotrub, O. V. Sedelnikova, A. D. Fedorenko [et al] // Materials. - 2023. – Vol. 16, iss. 4. – Art. 1650 (14 p.).</p> <p>3) Snegirev A. V. Electron diffusion induced valley Hall effect and nonlinear galvanodiffusive transport in hexagonal two-dimensional Dirac monolayer materials / A. V. Snegirev, V. M. Kovalev, M. V. Entin // Physical Review. B. – 2023. – Vol. 107, iss. 8. – Art. 085415 (9 p.).</p> <p>4) Kinetically driven thermal roughening of semiconductor surfaces: experiment on</p>

GaAs and Monte Carlo simulation / D. M. Kazantsev, N. L. Shwartz [et al] // *Physica Scripta*. – 2023. – Vol. 98, iss. 3. – Art. 035702.

5) Load resistance influence on the Bennet doubler based electrostatic mechanical-to-electrical energy converter operation / V. P. Dragunov, D. I. Ostertak, K. G. Pelmenev, R. E. Sinitskiy, E. V. Dragunova // *Sensors and Actuators. A: Physical*. – 2023. – Vol. 351. – Art. 114162 (12 p.).

6) Evolution of the atomic and electronic structures during nitridation of the Si(111) surface under ammonia flux / V. G. Mansurov, Y. G. Galitsyn, T. V. Malin, S. A. Teys, D. S. Milakhin, K. S. Zhuravlev. - DOI 10.1016/j.apsusc.2021.151276. - Text : direct // *Applied Surface Science*. - 2022. - Vol. 571. - Art. 151276 (11 p.).

7) Mg₃N₂ nanocrystallites formation during the GaN:Mg layers growth by the NH₃-MBE technique / T. V. Malin, V. G. Mansurov, Y. G. Galitsyn, D. S. Milakhin, D. Y. Protasov, B. Y. Ber, D. Y. Kazantsev, V. V. Ratnikov, M. P. Shcheglov, N. Smirnov, V. Y. Davydov, K. S. Zhuravlev // *Journal of Crystal Growth*. - 2021. - Vol. 554. - Art. 125963 (8p).

8) Surface chemical treatment effect on (111) PbSnTe < In > topological crystalline insulator films / A. E. Klimov [et al.]. - DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.150930. – Text : direct // *Applied Surface Science*. - 2021. - Vol. 569. - Art. 150930 (6 p.).

9) Visualization of swift ion tracks in suspended local diamondized few-layer graphene / I. V. Antonova [et al.]. - DOI 10.3390/ma16041391. - Text : electronic // *Materials*. - 2023. – Vol. 16, iss. 4. – Art. 1391 (14 p.).

10) Bi₂Se₃ nanolayer growth on 2D printed graphene / I. V. Antonova, K. A. Kokh, N. A. Nebogatikova, E. A. Suprun [et. al.]. - DOI 10.1021/acs.cgd.2c00431. -

Text : direct // Crystal Growth and Design. – 2022. – Vol. 22, iss. 9. – P. 5335–5344.

11) Nastovjak A. G. Simulation of GaAs nanowire annealing / A. G. Nastovjak, D. V. Shterental, N. L. Shwartz. – DOI 10.1016/j.commatsci.2023.112310. – Text : direct // Computational Materials Science. – 2023. – Vol. 228. – Art. 112310.

12) Kudrich S. V. Gold Drop Formation and Motion over a Si(111) Substrate: Monte Carlo Simulation / S. V. Kudrich, A. A. Spirina, N. L. Shwartz. - DOI 10.3103/S8756699022060061. - Text : direct // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. - 2022. - Vol. 58, iss. 6. - P. 608-615.

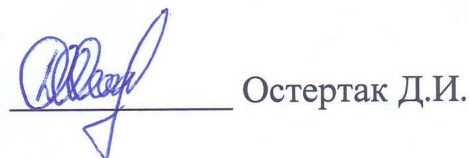
13) Bogolon-mediated light absorption in atomic condensates of different dimensionality / D. Ko, V. Kovalev [et al.]. – DOI 10.1038/s41598-023-33091-5. – Text : electronic // Scientific Reports. - 2023. – Vol. 13, iss. 1. – Art. 6358 (7 p.).

14) Photogalvanic transport in fluctuating Ising superconductors / A. V. Parafilo, M. V. Boev, V. M. Kovalev, I. G. Savenko. - DOI 10.1103/PhysRevB.106.144502. - Text : direct // Physical Review. B. - 2022. – Vol. 106, iss. 14. – Art. 144502 (6 p.).

Проректор по научной работе,
к.т.н.

 Отто А.И.

Заведующий кафедрой Полупроводниковых приборов и микроэлектроники,
к.т.н., доцент

 Остертак Д.И.

« 28 » _____ 2023 г.

